

ABSTRACT BOOK

II UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA



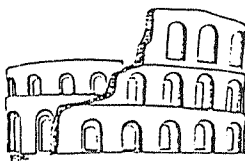
TOR VERGATA

TOR VERGATA
CLINICA NEUROLOGICA
NEUROFISIOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA



A3-02

1989



Riunione Primaveraile
Società Italiana di Elettroencefalografia
e Neurofisiologia Clinica
Société de Neurophysiologie Clinique de
Langue Française

Roma 22 - 24 maggio 1989
Rome 22 - 24 mai 1989

ASIMMETRIA EEG DURANTE SONNO

Massetani R., Bonanni E., Murri L., Barcaro U.,* Navona C.,* Denoth F.*

Servizio di Neurofisiopatologia, Pisa

*Istituto di Elaborazione dell'Informazione, CNR, Pisa

Le manifestazioni EEG durante il sonno sono essenzialmente bilaterali ma lievi differenze di lato sono state descritte utilizzando differenti tecniche di analisi automatica.

Dopo la prima osservazione di Goldstein e coll. che descrivevano una minore ampiezza a destra durante il REM, vari tentativi sono stati effettuati in differenti laboratori per replicare tale risultato. La nostra esperienza basata sulla potenza del segnale confermava in parte i risultati di Goldstein e coll. ma altri gruppi ottennero dati contrastanti, verosimilmente dovuti a vari fattori legati a differenze nella posizione degli elettrodi, nella tecnica utilizzata e nella elaborazione dei dati.

Abbiamo pertanto utilizzato il calcolo dei coefficienti di cross-correlation interemisferica per l'attività delta (1-4 Hz) e sigma (12.5-14.5 Hz).

E' stato indagato il sonno di 17 soggetti normali di differente età. Con notevole frequenza è stato osservato che nei giovani (9 su 11) vi erano variazioni di uno o di entrambi i coefficienti durante il sonno e che tali variazioni erano legate al ciclo REM/NREM. Lo stesso andamento è stato riscontrato in 5 dei 6 soggetti in età senile (61-66 anni).

Questa metodica ha il vantaggio di ridurre i dati controversi, poiché i coefficienti di correlazione sono indipendenti dalle differenze di ampiezza fra il segnale di destra e di sinistra, differenze che possono essere sostenute da una alterata asimmetria nella posizione degli elettrodi o da variazioni di impedenza.